



概要

RF電源を搭載した小型の高周波スパッタリング装置です。金属、半導体、絶縁物の成膜が可能のため、基礎研究開発等の実験用に最適です。

特徴及び使用上の注意

- 絶縁物・金属・半導体材料のスパッタ装置です。
- メインポンプに油拡散ポンプを使用しています。
- $\phi 80\text{mm} \times 1$ 基のカソードで、単層成膜が可能です。
- コンベンショナルスパッタで、スパッタ速度 $20\text{nm/min}(\text{SiO}_2)$ が得られます。

仕様

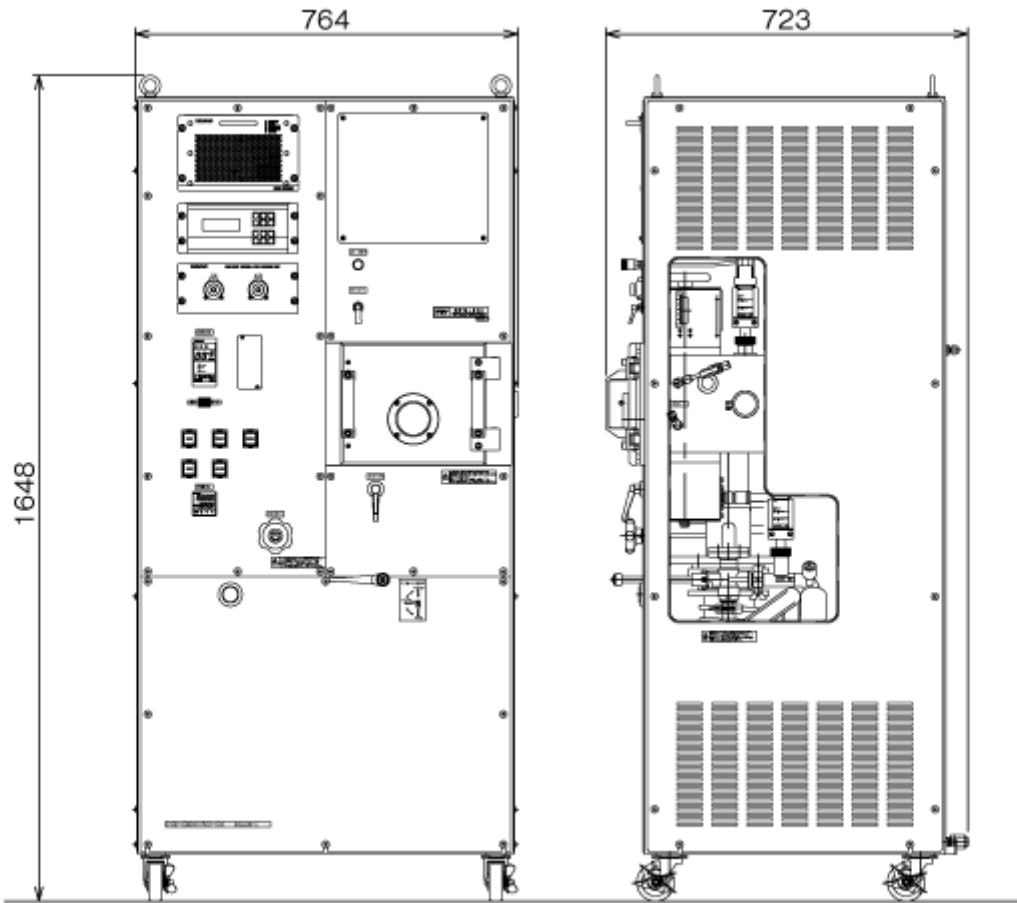
項目	単位	値
到達圧力	Pa	6.6×10 ⁻⁴
	kPa	-101.3 ^{#1}
排気時間		6.6×10 ⁻³ Pa/5min
真空層		金属チャンパー(200mm(W)×250mm(D)×150mm(H))
カソード		φ 80mm、1元
基板推奨サイズ		φ 80mm×t1-5mm
有効成膜範囲		50mm
成膜速度	mm	SiO2 成膜にて、20nm/min以上
膜厚分布		SiO2 成膜にて、50mm領域±8%以内
基板加熱温度		Max 350℃
基板/電極間距離		30～50mm(可変)
メインポンプ		油拡散ポンプ(水冷) 150L/sec
液体窒素トラップ		オプション
補助ポンプ		油回転真空ポンプ 100L/min
オイルミストトラップ		OMT-100A
メインバルブ		クラップーバルブ
補助バルブ		三方向バルブ
自動リークバルブ		オプション
操作		手動
RF電源		Max 300W(0～300W可変)
ピラニ真空計		G-TRAN
電離真空計		オプション
最大寸法	mm	764(W) × 723(L) × 1648(H)
質量	kg	260
RoHS対応		

#1: 単位が[kPa]の到達圧力はゲージ圧表示です。

ユーティリティ

項目	単位	値
所要電気量(本体)		単相 (200V)(50/60Hz): 2.8kVA
アース端子		A種 (接地抵抗値 10Ω以下)
所要水量		5.0 L/min (水温:25℃以下、水圧:200 300kPa (ゲージ圧))
取り合い(電源)		ビニルキャブタイヤケーブル(R2-5 圧着端子付) 4m
取り合い(アース)		アースケーブル(銅板) 4m
取り合い(水)		テロンブレードホース(内径9mm×外径15mm)、4m(2本)

寸法図および対応表



特記事項

- 冷却水配管は、お客様にて準備願います。
- 高周波申請が必要です。

対応オプションパーツ

No.	分類名	シリーズ	品名
1	成膜装置オプションパーツ	自動リークバルブ	補助ポンプ用自動リークバルブ
2	成膜装置オプションパーツ		ガス導入ポート
3	成膜装置オプションパーツ		ゲージポートセット
4	成膜装置オプションパーツ		ハーメチックシールポートセット
5	成膜装置オプションパーツ		液体窒素トラップ
6	インライントラップ	OMIシリーズ	OMI-100
7	成膜装置オプションパーツ	基板加熱装置	基板加熱装置 SH-650F
8	成膜装置オプションパーツ	封止フランジセット	封止フランジセット

アルバック機工株式会社 〒881-0037 宮崎県西都市大字茶臼原291-7 TEL:(0983)42-1411(代) FAX:(0983)42-1422	
---	--